

## (12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2002年7月4日 (04.07.2002)

PCT

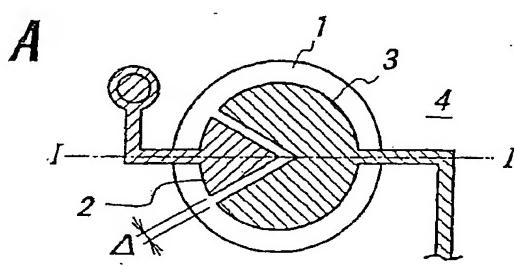
(10) 国際公開番号  
WO 02/052600 A1

- (51) 国際特許分類7: H01J 1/304, 1/316, 29/04, 31/12 (72) 発明者: 武内 幸久 (TAKEUCHI, Yukihisa); 〒467-8530 愛知県 名古屋市 瑞穂区 須田町 2番 5 6 号 日本碍子株式会社内 Aichi (JP). 七瀧 努 (NANATAKI, Tsumoru); 〒467-8530 愛知県 名古屋市 瑞穂区 須田町 2番 5 6 号 日本碍子株式会社内 Aichi (JP). 大和田 嶽 (OHWADA, Iwao); 〒467-8530 愛知県 名古屋市 瑞穂区 須田町 2番 5 6 号 日本碍子株式会社内 Aichi (JP). 堀内 智哉 (HORIUCHI, Tomoya); 〒467-8530 愛知県 名古屋市 瑞穂区 須田町 2番 5 6 号 日本碍子株式会社内 Aichi (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP01/11195
- (22) 国際出願日: 2001年12月20日 (20.12.2001)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願2000-390299  
2000年12月22日 (22.12.2000) JP
- (71) 出願人: 日本碍子株式会社 (NGK INSULATORS, LTD.) [JP/JP]; 〒467-8530 愛知県 名古屋市 瑞穂区 須田町 2番 5 6 号 Aichi (JP).
- (74) 代理人: 杉村 興作, 外 (SUGIMURA, Kosaku et al.); 〒100-0013 東京都 千代田区 霞が関 3丁目 2番 4号 霞山ビルディング Tokyo (JP).
- (81) 指定国(国内): JP.

[統葉有]

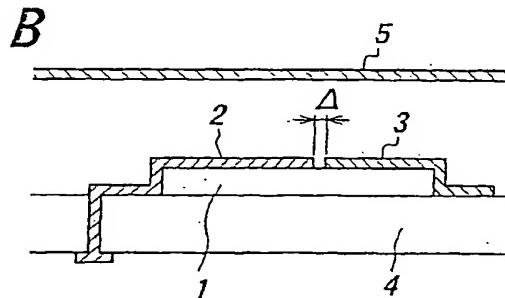
(54) Title: ELECTRON EMISSION ELEMENT AND FIELD EMISSION DISPLAY USING IT

(54) 発明の名称: 電子放出素子及びそれを用いたフィールドエミッションディスプレイ



(57) Abstract: An electron emission element, which comprises an electric field application unit composed of a dielectric, a first electrode formed on one surface thereof, and a second electrode formed on the same surface, for forming a slit along with a drive electrode, and which is formed on a substrate.

(57) 要約:



電子放出素子は、誘電体によって構成された電界印加部と、その一方の面に形成された第1電極と、それと同一面に形成され、駆動電極とともにスリットを形成する第2電極とを有し、基板の上に形成される。

WO 02/052600 A1



(84) 指定国(広域): ヨーロッパ特許(AT, BE, CH, CY, DE,  
DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される  
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語  
のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

一 國際調査報告書

## 明細書

## 電子放出素子及びそれを用いたフィールドエミッショニスプレイ

## 技術分野

本発明は、電子放出素子及びそれを用いたフィールドエミッショニスプレイに関するものである。

## 背景技術

このような電子放出素子は、駆動用の電極及び接地用の電極を有し、フィールドエミッショニスプレイ (FED) やバックライトのような種々のアプリケーションに適用されている。FEDに適用する場合、複数の電子放出素子を2次元的に配列し、これら電子放出素子に対する複数の蛍光体が、所定の間隔を以つてそれぞれ配置されている。

しかしながら、従来の電子放出素子の直進性、すなわち、放出された電子が所定の対象（例えば蛍光体）に直進する程度が良好でなく、放出された電子によって所望の電流密度を確保するためには、比較的高い電圧を電子放出素子に印加する必要がある。

また、従来の電子放出素子をFEDに適用した場合、直進性が良好でないためにクロストークが比較的大きくなる、すなわち、放出された電子が、対応する蛍光体に隣接する蛍光体に入射するおそれが高くなる。その結果、蛍光体のピッチを狭くするのが困難となり、隣接する蛍光体に電子が入射されるのを防止するためにグリッドを設ける必要がある。

本発明の目的は、良好な放出電子の直進性を有する電子放出素子並びにそれを用いたフィールドエミッショニスプレイを提供することである。

本発明の他の目的は、比較的低真空で、非常に低い駆動電圧にて高い電流密度を有する電子放出を実現する電子放出素子及びそれを用いたフィールドエミッショニスプレイである。

ョンディスプレイを提供することである。

#### 発明の開示

本発明による電子放出素子は、

誘電体によって構成された電界印加部と、

この電界印加部の一方の面に形成された第1電極と、

前記電界印加部の一方の面に形成され、前記第1電極とともにスリットを形成する第2電極とを有することを特徴とするものである。

本発明によれば、第1又は第2電極にパルス電圧を印加すると、電界印加部から電子が放出される。電界印加部を誘電体によって構成することによって、従来の電子放出素子では達成できない良好な直進性を得ることができる。その結果、所望の電流密度を確保するために電子放出素子に印加される電圧が従来に比べて著しく低くなり、消費エネルギーが大幅に低減される。なお、第1及び第2電極を厚膜印刷によって電界印加部に形成することができるので、本発明による電子放出素子は、耐久性及びコスト低減の観点からも好ましい。

電子放出素子に印加される電圧を更に低減させるために、前記第1電極、第2電極及びスリットにカーボンコーティングを施すが好ましい。この場合、カーボンコーティングによって、電子とイオンとの衝突や発熱による第1及び第2電極の損傷のおそれが著しく軽減する。

電子の放出を良好に行うために、前記第1及び第2電極に対して所定の間隔を以って配置した第3電極を更に有し、前記第1及び第2電極と前記第3電極との間の空間を真空とするのが好ましい。

本発明による他の電子放出素子は、

圧電材料、電歪材料及び反強誘電材料のうちの少なくとも1種類によって構成された電界印加部と、

この電界印加部の一方の面に形成された第1電極と、

前記電界印加部の一方の面に形成され、前記第1電極とともにスリットを形成

する第2電極とを有することを特徴とするものである。

本発明によれば、良好な直進性が得られるだけでなく、第1又は第2電極にパルス電圧を印加した際に、電界印加部が、アクチュエータとしても機能し、屈曲変位する。その結果、電子放出素子の直進性が更に向上する。

電子放出素子に印加される電圧を更に低減させるために、前記第1電極、第2電極及びスリットにカーボンコーティングを施すが好ましい。この場合、カーボンコーティングによって、電子とイオンとの衝突や発熱による第1及び第2電極の損傷のおそれが著しく軽減する。

この場合も、電子の放出を良好に行うために、前記第1及び第2電極に対して所定の間隔を以って配置した第3電極を更に有し、前記第1及び第2電極と前記第3電極との間の空間を真空とするのが好ましい。この際には、電界印加部がアクチュエータとしても機能し、その変位動作によって、放出電子量を制御することができる。

好適には、前記第3電極に直流のオフセット電圧を印加する電圧源と、この電圧源と前記第3電極との間に直列配置した抵抗とを更に有する。これによって、所望の電流密度を容易に達成することができるとともに、第3電極と第1及び第2電極との間の短絡が防止される。

例えば、前記第1電極にパルス電圧が印加されるとともに、前記第2電極に直流のオフセット電圧が印加される。

好適には、前記第1電極と電圧信号源との間に直列配置したコンデンサを更に有する。これによって、コンデンサを充填するまでの時間のみ第1電極と第2電極との間に電圧を印加することができ、その結果、第1及び第2電極の短絡による破損が防止される。

前記電界印加部の他方の面に形成され、前記第1電極に対応する第4電極を更に有する場合、第1電極と第3電極との間の電界印加部がコンデンサの機能を果たすので、第1及び第2電極の短絡による破損が防止される。この場合、例えば、

前記第4電極にパルス電圧が印加されるとともに、前記第2電極に直流のオフセット電圧が印加される。

前記第2電極と直流オフセット電圧源との間に直列配置した抵抗を更に有してもよい。この場合、第1電極から第2電極に放電して流れる電流が抵抗によって抑制され、第1及び第2電極の短絡による破損が防止される。

印加電圧の大幅な低減を図るために、前記電界印加部の比誘電率を1000以上とし、及び／又は、前記スリットの幅を500μm以下とするのが好ましい。

電子の放出を良好に行うために、前記第1電極と第2電極のうちの少なくとも一方が、鋭角を成す角部を有し、及び／又は、前記第1電極及び第2電極がカーボンナノチューブを有するのが好ましい。

本発明によるフィールドエミッショニディスプレイは、

2次元的に配列された複数の電子放出素子と、

これら電子放出素子に対してそれぞれ所定の間隔を以って配置した複数の蛍光体とを具え、

前記電流放出素子の各々が、

誘電体によって構成された電界印加部と、

この電界印加部の一方の面に形成された第1電極と、

前記電界印加部の一方の面に形成され、前記第1電極とともにスリットを形成する第2電極とを有することを特徴とするものである。

本発明によれば、電子放出素子の直進性が優れているので、従来の電子放出素子を有する場合に比べてクロストークが小さくなり、蛍光体のピッチを狭くすることができ、かつ、隣接する蛍光体に電子が入射されるのを防止するためにグリッドを設ける必要がなくなる。その結果、本発明によるフィールドエミッショニディスプレイは、解像度の向上、装置の小型化及びコスト低減の観点から好ましい。なお、フィールドエミッショニディスプレイ内部の真空度が比較的低い場合でも電子の放出が可能であるため、蛍光体励起などの原因で内部の真空度が低下

しても電子の放出を維持することができる。なお、従来のフィールドエミッショントライディスプレイでは、このような真空中度の低下に対して、電子放出を維持するためのマージンとして真空空間を比較的大きく確保する必要があり、ディスプレイの薄型化が困難であった。それに対して、本発明では、真空中度の低下に対して電子の放出を維持するために真空空間を予め大きく確保する必要がないので、ディスプレイの薄型化が可能となる。

電子放出素子に印加される電圧を更に低減させるために、前記第1電極、第2電極及びスリットにカーボンコーティングを施すのが好ましい。この場合、カーボンコーティングによって、電子とイオンとの衝突や発熱による第1及び第2電極の損傷のおそれが著しく軽減する。

電子の放出を良好に行うために、前記第1及び第2電極に対して所定の間隔を以って配置した第3電極を更に有し、前記第1及び第2電極と前記第3電極との間の空間を真空とするのが好ましい。

本発明による他のフィールドエミッショントライディスプレイは、

2次元的に配列された複数の電子放出素子と、

これら電子放出素子に対してそれぞれ所定の間隔を以って配置した複数の蛍光体とを具え、

前記電流放出素子の各々が、

圧電材料、電歪材料及び反強誘電材料のうちの少なくとも1種類によって構成された電界印加部と、

この電界印加部の一方の面に形成された第1電極と、

前記電界印加部の一方の面に形成され、前記第1電極とともにスリットを形成する第2電極とを有することを特徴とするものである。

本発明によれば、電子放出素子の直進性が更に良好になるので、本発明によるフィールドエミッショントライディスプレイは、小型化及びコスト低減の観点から更に好ましくなる。

電子放出素子に印加される電圧を更に低減させるために、前記第1電極、第2電極及びスリットにカーボンコーティングを施するが好ましい。この場合、カーボンコーティングによって、電子とイオンとの衝突や発熱による第1及び第2電極の損傷のおそれが著しく軽減する。

この場合も、電子の放出を良好に行うために、前記第1及び第2電極に対して所定の間隔を以って配置した第3電極を更に有し、前記第1及び第2電極と前記第3電極との間の空間を真空とするのが好ましい。この際には、電界印加部がアクチュエータとしても機能し、その変位動作によって、放出電子量を制御することができる。

好適には、前記第3電極に直流のオフセット電圧を印加する電圧源と、この電圧源と前記第3電極との間に直列配置した抵抗とを更に有する。これによって、所望の電流密度すなわち蛍光体の発光量を容易に達成することができるとともに、第3電極と第1及び第2電極との間の短絡が防止される。

例えば、前記第1電極にパルス電圧が印加されるとともに、前記第2電極に直流のオフセット電圧が印加される。

好適には、前記第1電極と電圧信号源との間に直列配置したコンデンサを更に有する。これによって、第1及び第2電極の短絡による破損が防止される。

前記電界印加部の他方の面に形成され、前記第1電極に対応する第4電極を更に有する場合も、第1及び第2電極の短絡による破損が防止される。この場合、例えば、前記第4電極にパルス電圧が印加されるとともに、前記第2電極に直流のオフセット電圧が印加される。

前記第2電極と直流オフセット電圧源との間に直列配置した抵抗を更に有する場合も、第1及び第2電極の短絡による破損が防止される。

印加電圧の大幅な低減を図るために、前記電界印加部の比誘電率を1000以上とし、及び／又は、前記スリットの幅を $500\mu m$ 以下とするのが好ましい。

電子の放出を良好に行うために、前記第1電極と第2電極のうちの少なくとも

一方が、鋭角を成す角部を有し、及び／又は、前記第1電極及び第2電極がカーボンナノチューブを有するのが好ましい。

本発明によるフィールドエミッショニスプレイは、2次元的に配列された複数の電子放出素子を一体に形成した基板を更に具える。

#### 図面の簡単な説明

図1は、本発明による電子放出素子の第1の実施の形態を示す図である。

図2は、本発明による電子放出素子の第2の実施の形態を示す図である。

図3は、本発明による電子放出素子の第3の実施の形態を示す図である。

図4は、本発明による電子放出素子の第4の実施の形態を示す図である。

図5は、本発明による電子放出素子の第5の実施の形態を示す図である。

図6は、本発明による電子放出素子の第6の実施の形態を示す図である。

図7は、本発明による電子放出素子の動作を説明するための図である。

図8は、本発明による他の電子放出素子の動作を説明するための図である。

図9は、本発明によるFEDの実施の形態を示す図である。

図10は、本発明による電子放出素子の比誘電率と印加電圧との関係を示す図である。

図11は、図10を説明するための図である。

図12は、本発明による電子放出素子のスリット幅と印加電圧との関係を示す図である。

図13は、本発明による電子放出素子の第7の実施の形態を示す図である。

図14は、図13の電子放出素子の動作を説明するための図である。

図15は、本発明による電子放出素子の第8の実施の形態を示す図である。

図16は、図15の電子放出素子の動作を説明するための図である。

#### 発明を実施するための最良の形態

本発明による電子放出素子及びそれを用いたフィールドエミッショニスプレイの実施の形態を、図面を参照して詳細に説明する。

図1Aは、本発明による電子放出素子の第1の実施の形態の上面図であり、図1Bは、そのI—I断面図である。この電子放出素子は、誘電体によって構成された電界印加部1と、その一方の面に形成された第1電極としての駆動電極2と、それと同一面に形成され、駆動電極2とともにスリットを形成する第2電極としてのコモン電極3とを有し、基板4の上に形成される。好適には、この電子放出素子は、放出された電子を良好に捕獲するために、電界印加部1の一方の面に対して所定の間隔を配置した第3電極としての電子捕獲電極5を更に有し、これらの間の空間を真空状態に保持する。また、駆動電極2及びコモン電極3の短絡による破損を防止するために、駆動電極2と図示しない電圧信号源との間に、図示しないコンデンサを直列配置し、及び／又は、コモン電極3と図示しない直流オフセット電圧源との間に、図示しない抵抗を直列配置する。

電界印加部1を構成する誘電体として、好適には、比誘電率が比較的高い、例えば1000以上の誘電体を採用する。このような誘電体としては、チタン酸バリウムの他に、ジルコン酸鉛、マクネシウムニオブ酸鉛、ニッケルニオブ酸鉛、亜鉛ニオブ酸鉛、マンガンニオブ酸鉛、マグネシウムタンタル酸鉛、ニッケルタンタル酸鉛、アンチモンスズ酸鉛、チタン酸鉛、チタン酸バリウム、マグネシウムタンクスチタン酸鉛、コバルトニオブ酸鉛等又はこれらの任意の組合せを含有するセラミックスや、主成分がこれらの化合物を50重量%以上含有するものや、前記セラミックスに対して更にランタン、カルシウム、ストロンチウム、モリブデン、タンクスチタン、バリウム、ニオブ、亜鉛、ニッケル、マンガン等の酸化物若しくはこれらのいずれかの組合せ又は他の化合物を適切に添加したもの等を挙げができる。例えば、マグネシウムニオブ酸鉛(PMN)とチタン酸鉛(PT)の2成分系 $n$ PMN- $m$ PT( $n, m$ をモル数比とする。)においては、PMNのモル数比を大きくすると、キュリ一点が下げられて、室温での比誘電率を大きくすることができる。特に、 $n=0.85-1.0, m=1.0-n$ で比誘電率3000以上となり好ましい。例えば、 $n=0.91, m=0.09$ で室温の

比誘電率15000, n=0.95, m=0.05で室温の比誘電率20000が得られる。次に、マグネシウムニオブ酸鉛(PMN)、チタン酸鉛(PT)、ジルコン酸鉛(PZ)の3成分系では、PMNのモル数比を大きくする他に、正方晶と擬立方晶又は正方晶と菱面体晶のモルフォトロピック相境界(MPB:Morphotropic Phase Boundary)付近の組成とすることが比誘電率を大きくするのに好ましい。例えば、PMN:PT:PZ=0.375:0.375:0.25にて比誘電率5500, PMN:PT:PZ=0.5:0.375:0.125にて比誘電率4500となり、特に好ましい。さらに、絶縁性が確保できる範囲内でこれらの誘電体に白金のような金属を混入して、誘電率を向上させるのが好ましい。この場合、例えば、誘電体に白金を重量比で20%混入させる。

本実施の形態では、駆動電極2は、鋭角を成す角部を有する。駆動電極2には、図示しない電源からパルス電圧が印加され、主に角部から電子が放出される。なお、電子の放出を良好に行うために、駆動電極2とコモン電極3との間のスリットの幅△を、好適には $500\mu\text{m}$ 以下にする。駆動電極2を、高温酸化雰囲気に対して耐性を有する導体、例えば金属単体、合金、絶縁性セラミックスと金属単体との混合物、絶縁性セラミックスと合金との混合物等によって構成し、好適には、白金、パラジウム、ロジウム、モリブデン等の高融点貴金属や、銀-パラジウム、銀-白金、白金-パラジウム等の合金を主成分とするものや、白金とセラミックス材料とのサーメット材料によって構成する。更に好適には、白金のみ又は白金系の合金を主成分とする材料によって構成する。また、電極として、カーボン、グラファイト系の材料、例えば、ダイヤモンド薄膜、ダイヤモンドライカーボン、カーボンナノチューブも好適に使用される。なお、電極材料中に添加させるセラミックス材料の割合は、5-30体積%程度が好適である。

駆動電極2を形成するに当たり、上記材料を用いて、スクリーン印刷、スプレー、コーティング、ディッピング、塗布、電気泳動法等の各種の厚膜形成方法や、スパッタリング、イオンビーム、真空蒸着、イオンプレーティング、CVD、め

つき等の各種の薄膜形成手法による通常の膜形成手法に従って形成することができ、好適には、これら厚膜形成手法によって形成される。

厚膜形成手法によって駆動電極2を形成する場合、その厚さは、一般的には20 μm以下となり、好適には5 μm以下となる。

コモン電極3には、直流のオフセット電圧が印加され、図示しないスルーホールを通じて基盤4の裏面から配線として引き出される。

コモン電極3は、駆動電極2と同様な材料及び手法によって形成されるが、好適には上記厚膜形成手法によって形成する。コモン電極3の厚さも、一般的には20 μm以下とし、好適には5 μm以下とする。

駆動電極2に電気的に接続した配線と、コモン電極3に電気的に接続した配線とを電気的に分離するために、基板4を電気的な絶縁材料で構成するのが好ましい。

したがって、基板4を、高耐熱性の金属や、その金属表面をガラスなどのセラミックス材料によって被覆したホーローのような材料によって構成することができるが、セラミックスで構成するのが最適である。

基板4を構成するセラミックスとしては、例えば、安定化された酸化ジルコニウム、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、酸化チタン、スピネル、ムライト、窒化アルミニウム、窒化珪素、ガラス、これらの混合物等を使用することができる。その中でも、酸化アルミニウム及び安定化された酸化ジルコニウムが、強度及び剛性の観点から好ましい。安定化された酸化ジルコニウムは、機械的強度が比較的高いこと、韌性が比較的高いこと、駆動電極2及びコモン電極3との化学反応が比較的小さいことなどの観点から特に好適である。なお、安定化された酸化ジルコニウムとは、安定化酸化ジルコニウム及び部分安定化酸化ジルコニウムを包含する。安定化された酸化ジルコニウムでは、立方晶などの結晶構造をとるため、相転移が生じない。

一方、酸化ジルコニウムは、1000°C前後で单斜晶と正方晶との間を相転移

し、このような相転移の際にクラックが発生するおそれがある。安定化された酸化ジルコニウムは、酸化カルシウム、酸化マグネシウム、酸化イットリウム、酸化スカンジウム、酸化イッテルビウム、酸化セリウム、希土類金属の酸化物等の安定剤を、1—30モル%含有する。なお、基板4の機械的強度を向上させるために、安定化剤が酸化イットリウムを含有するのが好適である。この場合、酸化イットリウムを、好適には1.5—6モル%、更に好適には2—4モル%含有し、更に0.1—5モル%の酸化アルミニウムを含有するのが好ましい。

また、結晶相を、立方晶+単斜晶の混合相、正方晶+単斜晶の混合相、立方晶+正方晶+単斜晶の混合相等とすることができますが、その中でも、主たる結晶相を、正方晶又は正方晶+立方晶の混合相としたものが、強度、韌性及び耐久性の観点から最適である。

基板4をセラミックスから構成した場合、比較的多数の結晶粒が基板4を構成するが、基板4の機械的強度を向上させるためには、結晶粒の平均粒径を、好適には0.05—2μmとし、更に好適には0.1—1μmとする。

電界印加部1、駆動電極2及びコモン電極3をそれぞれ形成する度に熱処理すなわち焼成して基板4と一体構造にすることができ、また、これら電界印加部1、駆動電極2及びコモン電極3を形成した後、同時に熱処理すなわち焼成して、これらを同時に基板4に一体に結合することもできる。

なお、駆動電極2及びコモン電極3の形成手法によっては、一体化のための熱処理すなわち焼成を必要としない場合もある。

基板4と、電界印加部1、駆動電極2及びコモン電極3とを一体化させるための熱処理すなわち焼成温度としては、一般に500—1400℃の範囲とし、好適には、1000—1400℃の範囲とする。さらに、膜状の電圧印加部1を熱処理する場合、高温時に電界印加部1の組成が不安定にならないように、電界印加部1の蒸発源とともに雰囲気制御を行いながら熱処理すなわち焼成を行うのが好ましく、また、電界印加部1を適切な部剤によってカバーし、電界印加部1の

表面が焼成雰囲気に直接露出しないようにして焼成する手法を採用するのが好ましい。この場合、カバーする部材としては、基板4と同様な材料を用いることとなる。

図2Aは、本発明による電子放出素子の第2の実施の形態の上面図であり、図2Bは、そのII-II断面図である。この電子放出素子は、電界印加部1、駆動電極2及びコモン電極3にそれぞれ対応する電界印加部11、駆動電極12及びコモン電極13の他に、電界印加部11の他方の面に形成された第4電極としての駆動端子電極14を更に有し、基板15の上に形成される。この場合も、好適には、電子放出素子は、放出された電子を良好に捕獲するために、電界印加部1の一方の面に対して所定の間隔を配置した第3電極としての電子捕獲電極16を更に有し、これらの間の空間を真空状態に保持する。

本実施の形態では、駆動電極12と駆動端子電極14との間の電界印加部11がコンデンサの役割を果たすので、駆動電極12及びコモン電極13の短絡による破損を防止するためにコンデンサを別に設ける必要がなくなる。この場合、駆動端子電極14にパルス電圧が印加されるとともに、コモン電極13に直流のオフセット電圧が印加される。

駆動端子電極14も、駆動電極12及びコモン電極13と同様な材料及び手法によって形成されるが、好適には上記厚膜形成手法によって形成する。駆動端子電極14の厚さも、一般的には20μm以下、好適には5μm以下にする。

図3Aは、本発明による電子放出素子の第3の実施の形態の上面図であり、図3Bは、そのIII-III断面図である。本実施の形態では、第1の実施の形態と同様に電界印加部21の一方の面に駆動電極22及びコモン電極23が形成されるが、これら駆動電極22及びコモン電極23の表面には複数のカーボンナノチューブ(CNT)が設けられており、これによって、駆動電極22にパルス電圧を印加するとともに、コモン電極23に直流のオフセット電圧を印加すると、CNTの先端から電子が放出されやすくなる。

図4Aは、本発明による電子放出素子の第4の実施の形態の上面図であり、図4Bは、そのIV-IV断面図である。本実施の形態では、第2の実施の形態と同様に電界印加部31の一方の面に駆動電極32及びコモン電極33が形成されるとともにその他方の面に駆動端子電極34が形成されているが、これら駆動電極32及びコモン電極33の表面には複数のカーボンナノチューブ(CNT)が設けられており、これによって、駆動端子電極33にパルス電圧を印加するとともに、コモン電極33に直流のオフセット電圧を印加すると、CNTの先端から電子が放出されやすくなる。

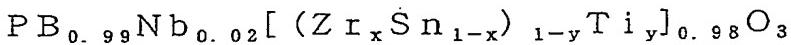
図5Aは、本発明による電子放出素子の第5の実施の形態の上面図であり、図5Bは、そのV-V断面図である。本実施の形態では、電界印加部41の一方の面に櫛歯形状の駆動電極42及びコモン電極43を形成する。この場合、駆動電極42にパルス電圧が印加されるとともに、コモン電極43に直流のオフセット電圧が印加されると、これら駆動電極42及びコモン電極43の角部から電子が放出されやすくなる。

図6Aは、本発明による電子放出素子の第6の実施の形態の上面図であり、図6Bは、そのVI-VI断面図である。本実施の形態では、電子放出素子は、反強誘電材料によって構成した電界印加部51a, 51bと、その一方の面にそれぞれ形成した櫛歯形状の駆動電極52a, 52b及びコモン電極53a, 53bとを有する。

電子放出素子は、スペーサ層54を介して基板55の上に設けられたシート層56の上に配置される。これによって、電界印加部51a, 51b、駆動電極52a, 52b、コモン電極53a, 53b、シート層56及びスペーサ層54は、アクチュエータ57a, 57bをそれぞれ構成する。

電界印加部51a, 51bを構成する反強誘電材料としては、ジルコン酸鉛を主成分とするもの、ジルコン酸鉛とスズ酸鉛とからなる成分を主成分とするもの、ジルコン酸鉛に酸化ランタンを添付したもの、ジルコン酸鉛とスズ酸鉛とからな

る成分に対してジルコン酸鉛やニオブ酸鉛を添加したものを用いるのが好適である。特に、低電圧で駆動させる場合には、ジルコン酸鉛とスズ酸鉛とからなる成分を含む反強誘電材料を用いるのが好適である。この組成は、以下のようになる。



また、反強誘電材料を多孔質にすることもでき、この場合、気孔率を 30% 以下にするのが好適である。

電界印加部 51a, 51b を形成するに当たり、上記厚膜形成手法を用いて形成するのが好適であり、微細な印刷を廉価に行うことができるという理由から、スクリーン印刷法が特に好適に用いられる。なお、電界印加部 51a, 51b の厚さとしては、低作動電圧で大きな変位を得るなどの理由から、スクリーン印刷法が特に好適に用いられる。なお、電界印加部 51a, 51b の厚さとしては、低作動電圧で大きな変位を得るなどの理由から、好適には 50 μm 以下とし、更に好適には、3 – 40 μm とする。

このような厚膜形成手法によって、平均粒子径が 0.01 – 7 μm 程度、好適には 0.05 – 5 μm 程度の反強誘電材料のセラミック粒子を主成分とするペーストやスラリーを用いて、シート層 56 の表面上に膜形成することができ、良好な素子特性が得られる。

電気泳動法は、高密度かつ高い形状制御で膜を形成でき、技術文献「DENKI KAGAKU 53, No. 1 (1985), p 63 – 68 安斎和夫著」や、「第1回電気泳動法によるセラミックスの高次成形法 研究討論会 予稿集 (1998), p 5 – 6, p 23 – 24」に記載されているような特徴を有する。したがって、要求精度、信頼性等を考慮して、各種手法を適切に選択して用いるのが好適である。

シート層 56 は、比較的肉薄に形成され、外部応力に対して振動を受けやすい構造となっている。シート層 56 を、好適には高耐熱性材料で構成する。その理由は、図 2 及び 4 のように駆動端子電極をシート層 56 に直接接合するに当たり、

有機接着剤などの耐熱性の比較的低い材料を使用することなくシート層56を直接支持する構造をとる場合、少なくとも電界印加部51a, 51bの形成時にシート層56が変質するのを防止するためである。なお、シート層56をセラミックスで構成する場合、図1の基板4と同様に構成する。

スペーサ層54を、好適にはセラミックスから構成するが、それを、シート層56を構成するセラミックス材料と同一とすることも、それとは異なるセラミックス材料とすることもできる。そのようなセラミックスとしては、シート層56を構成するセラミックス材料と同様に、例えば、安定化された酸化ジルコニウム、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、酸化チタン、スピネル、ムライト、窒化アルミニウム、窒化珪素、ガラス、これらの混合物等を使用することができる。

スペーサ層54、基板55及びシート層56を構成するセラミックス材料と異なるセラミックス材料としては、酸化ジルコニウムを主成分とする材料、酸化アルミニウムを主成分とする材料、これらの混合物を主成分とする材料等が好適に採用される。その中でも、酸化ジルコニウムを主成分としたものが特に好ましい。なお、焼結助剤として粘土などを添付することもあるが、酸化珪素、酸化ホウ素等のガラス化しやすいものが過剰に含まれないように、助剤成分を調整する必要がある。その理由は、これらガラス化しやすい材料は、電界印加部51a, 51bとの接合の観点からは有利であるが、電界印加部51a, 51bとの反応を促進し、電界印加部51a, 51bが所定の組成を維持するのが困難となり、その結果、素子特性を低下させる原因となるからである。

すなわち、スペーサ層54、基板55及びシート層56に含まれる酸化珪素などを、重量比で3%以下、好適には1%以下となるように制限するのが好ましい。ここで、主成分とは、重量比で50%以上の割合で存在する成分をいう。

スペーサ層54、基板55及びシート層56を3層の積層体として構成するのが好適であり、この場合、例えば、一体同時焼成、ガラスや樹脂によって各層を接合一体化又は後付けを行う。なお、4層以上の積層体とすることもできる。

本実施の形態のように電界印加部 51a, 51b を反強誘電体材料によって構成した場合、電界が加えられない状態では、電界印加部 51b のように平坦形状となり、それに対して、電界が加えられると、電界印加部 51a のように凸状に屈曲変位する。このように凸状に屈曲変位することによって、電子放出素子とそれに対向する電子捕獲電極 58 との間の間隔が狭くなるので、矢印で示したように発生する電子の直進性が更に良好になる。したがって、この屈曲変位量を以つて、電子捕獲電極 58 に到達する放出電子量を制御することが可能である。

次に、本発明による電子放出素子の動作を説明する。

図 7 は、本発明による電子放出素子の動作を説明するための図である。この場合、電流制御素子 61 は、図 1 に示す構成を有し、その周辺は、真空チャンバ 62 によって真空状態に保持される。また、駆動電極 63 とコモン電極 64 との間の短絡を防止するために、駆動電極 63 と電圧信号源 65 との間にコンデンサ 66 を直列配置している。駆動電極 63 及びコモン電極 64 に対向する電子捕獲電極 67 には、バイアス電圧 Vb が印加される。

信号電圧源 65 に印加される電圧  $V_1$  を -400V とし、コンデンサ 66 の容量を 500 pF とし、バイアス電圧 Vb を 0V とし、駆動電極 63 とコモン電極 64 とによって形成されるスリットの幅を 10 μm とし、真空チャンバ 62 の内部の真密度を  $1 \times 10^{-3}$  Pa とした場合、駆動電極 63 に流れる電流  $I_1$  が 2.0 A となり、電子捕獲電極 67 から取り出されるコレクタ電流  $I_c$  の密度が 1.2 A/cm<sup>2</sup> となる。その結果、本発明の電子放出素子によれば、従来の電子放出素子に比べて、低い電圧及び低い真密度で高い電流密度が得られ、その結果、優れた直進性を示す。なお、図 7B に示すように、コレクタ電流  $I_c$  は、バイアス電圧 Vb が高くなるに従って大きくなる。

図 8 は、本発明による他の電子放出素子の動作を説明するための図である。この場合、電流制御素子 71 は、図 2 に示す構成を有し、その周辺は、真空チャンバ 72 によって真空状態に保持される。また、駆動電極 73 とコモン電極 74 と

の間の短絡を防止するために、駆動電極 7 3 と駆動端子電極 7 5との間の電界印加部 7 6 がコンデンサの役割を果たす。駆動電極 7 3 及びコモン電極 7 4には、電子捕獲電極 7 7 が対向する。

信号電圧源 7 8 に印加される電圧  $V_1$  を  $-400\text{ V}$  とし、電界印加部 7 6 が  $530\text{ pF}$  の容量のコンデンサの役割を果たし、駆動電極 7 3 とコモン電極 7 4 によって形成されるスリットの幅を  $10\text{ }\mu\text{m}$  とし、真空チャンバ 7 2 の内部の真空度を  $1 \times 10^{-3}\text{ Pa}$  とした場合、駆動端子電極 7 5 に流れる電流  $I_1$  が  $2.0\text{ A}$  となり、電子捕獲電極 7 7 から取り出されるコレクタ電流  $I_c$  の密度が  $1.2\text{ A/cm}^2$  となる。その結果、本発明の他の電子放出素子によれば、従来の電子放出素子に比べて、低い電圧及び低い真空中で高い電流密度が得られ、その結果、優れた直進性を示す。なお、電圧  $V_1$ 、電流  $I_c$ 、 $I_1$ 、 $I_2$  の波形を、図 8 Bにおいて曲線 a-d でそれぞれ示す。

図 9 は、本発明による FED の実施の形態を示す図である。この FED は、2 次元的に配列された複数の電子放出素子 81R, 81G, 81B と、これら電子放出素子 81R, 81G, 81B に対してそれぞれ所定の間隔を以って配置した赤色蛍光体 82R、緑色蛍光体 82G 及び青色蛍光体 82B とを具える。

本実施の形態では、電子放出素子 81R, 81G, 81B が基板 83 に形成され、赤色蛍光体 82R、緑色蛍光体 82G 及び青色蛍光体 82B が電子捕獲電極 84 を介してガラス基板 85 に形成される。電子放出素子 81R, 81G, 81B は、図 2 に示す構造を有するが、図 1, 3-6 のうちのいずれかの構造を有することもできる。

本実施の形態によれば、電子放出素子 81R, 81G, 81B の直進性が優れているので、従来の電子放出素子を有する場合に比べてクロストークが小さくなり、蛍光体 82R, 82G, 82B のピッチを狭くすることができ、かつ、隣接する蛍光体 82R, 82G, 82B に電子が入射されるのを防止するためにグリッドを設ける必要がなくなる。その結果、本実施の形態の FED は、小型化及び

コスト低減の観点から好ましい。なお、真空度が比較的低い場合でも電子の放出が可能であるので、真空空間を予め大きくして真空度の低下に対するマージンをみる必要がなくなり、FEDの薄型化の制約が少なくなる。

図10は、本発明による電子放出素子の比誘電率と印加電圧との関係を示す図であり、図11は、それを説明するための図である。図10の特性は、図11に示すように駆動電極91とコモン電極92a-92cとによって形成されるスリットの幅d1, d2がいずれも $10\mu m$ である場合の電界印加部の比誘電率と、電界の放出に必要な印加電圧との関係を示す図である。

図10に示すように、従来の電子放出素子に比べて低い印加電圧を用いて電子放出素子を駆動させる場合、比誘電率を1000以上にするのが好ましいことがわかる。

図12は、本発明による電子放出素子のスリット幅と印加電圧との関係を示す図である。図12から、電子放出現象が生じるためにはスリット幅を $500\mu m$ 以下にする必要があることがわかる。なお、市販のプラズマディスプレイ、蛍光表示管又は液晶ディスプレイで用いられるドライバICで本発明による電子放出素子を駆動するためには、スリット幅を $20\mu m$ 以下にする必要がある。

図13Aは、本発明による電子放出素子の第7の実施の形態の上面図であり、図13Bは、そのVII-VII断面図である。本実施の形態では、電界印加部101の一方の側に半円形状の駆動電極102及びコモン電極103を形成し、駆動電極102、コモン電極103及びこれらによって形成されたスリットに一ポンコーティング104を施す。

図13に示す構成を有する電子放出素子の動作を、図14を用いて説明する。この場合、電流放出素子の周辺は、真空チャンバー111によって真空状態に保持される。駆動電極102とコモン電極103との間の短絡を防止するために、駆動電極102と電圧信号源112との間にコンデンサ113を直列配置している。駆動電極102及びコモン電極103に対向する電子捕獲電極114には、蛍光

体115が設けられ、バイアス電圧Vbが印加される。

駆動電極102及びコモン電極103は、膜厚3μmのAuであり、これら駆動電極102及びコモン電極103と、その間のスリット部とに対して、カーボン膜コーティング104（膜厚3μm）を行った。信号電圧源112に印加される電圧V<sub>k</sub>を25Vとし、コンデンサ113の容量を5nFとし、バイアス電圧Vbを300Vとし、電界印加部101を、比誘電率が14000の電歪材料で構成し、駆動電極102とコモン電極103とによって形成されるスリットの幅を10μmとし、真空チャンバ111の内部の真空度を $1 \times 10^{-3}$ Paとした場合、電子捕獲電極114に流れる電流Icは0.1Aとなり、駆動電極102に流れる電流I<sub>1</sub>（0.25A）に対して約40%の電流を電子流として取り出しており、駆動電極102とコモン電極103との間の電圧Vs、すなわち、電子の放出に必要な電圧が23.8Vとなる。その結果、図13に示す電子放出素子によれば、電子の放出に必要な電圧を著しく低くすることができる。また、カーボンコーティング104によって、電子又はイオンの衝突や発熱によって駆動電極102及びコモン電極103が損傷されるおそれが著しく軽減される。なお、駆動電極102に流れる電流I<sub>1</sub>、コモン電極103に流れる電流I<sub>2</sub>、Ic及び電圧Vsの波形を、図14Bにおいて曲線e-hでそれぞれ示す。

図15Aは、本発明による電子放出素子の第8の実施の形態の上面図であり、図15Bは、そのVII-VIII断面図である。本実施の形態では、電界印加部201の一方の側に半円形状の駆動電極202及びコモン電極203を形成する。

図15に示す構成を有する電子放出素子の場合、すなわち、カーボンコーティングを有しない場合でも、200Pa以下の低い真空度で電子を放出することを、図16を用いて説明する。この場合、電流放出素子の周辺は、真空チャンバ211によって真空状態に保持される。駆動電極202とコモン電極203との間の短絡を防止するために、駆動電極202と電圧信号源212との間にコンデ

ンサ213を直列配置している。駆動電極202及びコモン電極203に対向する電子捕獲電極214には、蛍光体215が設けられ、バイアス電圧Vbが印加される。

駆動電極202及びコモン電極203の材質は共にAuであり、信号電圧源212に印加される電圧V<sub>k</sub>を160Vとし、コンデンサ213の容量を5nFとし、バイアス電圧Vbを300Vとし、電界印加部201を、比誘電率が450の電歪材料で構成し、駆動電極202とコモン電極203とによって形成されるスリットの幅を10μmとし、真空チャンバ211の内部の真空度を200Pa以下とした場合、電子捕獲電極214に流れる電流Icは1.2Aとなり、駆動電極202に流れる電流I<sub>1</sub>(2A)に対して約60%の電流を電子流として取り出しており、駆動電極202とコモン電極203との間の電圧Vs、すなわち、電子の放出に必要な電圧が153Vとなる。なお、電流I<sub>1</sub>、I<sub>2</sub>、Ic及び電圧Vsの波形を、図16Bにおいて曲線i-1でそれぞれ示す。

上記のように200Pa以下の非常に低い真空度で十分な電子放出が可能なのは、カーボンコーティングを有する場合も同様である。

本発明による電子放出素子によれば、200Pa以下の非常に低い真空度で電子を放出することができるので、FEDを構成する場合、パネル外周部の封止空間を非常に小さくすることができるので、狭額縁パネルを実現することができる。また、複数のパネルを並べてディスプレイを大型化する場合、パネル間の継ぎ目が目立ちにくくなる。さらに、従来のFEDでは、蛍光体などから発生するガスによるFEDの内部空間の真空度が低下し、パネルの耐久性に悪影響を及ぼすおそれがあるが、本発明による電子放出素子を用いたディスプレイによれば、200Pa以下の非常に低い真空度で電子を放出することができるので、FEDの内部空間の真空度の低下による悪影響が大幅に軽減され、パネルの耐久性及び信頼性が大幅に向向上する。

本発明による電子放出素子及びそれを用いたFEDによれば、従来に比べて簡

単かつ小型化にすることができる。これについて具体的に説明すると、先ず、FEDの内部空間の真空度を低くすることができるので、FEDの外周封止部などの内外圧力差に対する筐体維持構造を簡単かつ小型化にすることができる。

また、電子を放出するために必要な印加電圧及び電子捕獲電極に印加すべきバイアス電圧を比較的低くすることができるので、FEDを耐圧構造とする必要がなくなり、装置全体の小型化及びパネルの薄型化が可能となる。なお、電子捕獲電極に印加すべきバイアス電圧を、0 V としてもよい。

また、本発明による電子放出素子の電界印加部を構成するに際し、スピント型の電子放出素子を構成する場合のように特殊な加工を必要とせず、さらに、電極及び電界印加部を厚膜印刷で形成できるので、本発明による電子放出素子及びそれを用いたFEDを、従来に比べて低コストで製造することができる。

さらに、電子を放出するために必要な印加電圧及び電子捕獲電極に印加すべきバイアス電圧を比較的低くすることができるので、耐圧が比較的小さい小型で廉価な駆動ICを使用することができるので、本発明による電界放出素子を用いたFEDを廉価に製造することができる。

本発明は、上記実施の形態に限定されるものではなく、幾多の変更及び変形が可能である。

例えば、本発明による電子放出素子を、バックライトのような他のアプリケーションに適用することもできる。本発明による電子放出素子は、比較的大量の電子線を比較的低い電圧で放出することができるので、紫外線放射方式が主流であった従来の殺菌装置に代えて、小型かつ高効率の殺菌装置を構成するのに好適である。また、本発明による電子放出素子は、角部を有する他の任意の電極構造を採用することができる。さらに、駆動電極とコモン電極との間の短絡を防止するために、第2電極すなわちコモン電極と直流オフセット電圧源との間に抵抗を直列配置することもできる。

第6の実施の形態において、電界印加部51a, 51bを反誘電材料によって

構成した場合について説明したが、電界印加部 51a, 51bを、圧電材料、電歪材料及び反誘電材料のうちの少なくとも1種類によって構成すればよい。圧電材料及び／又は電歪材料を用いる場合、例えば、ジルコン酸鉛（PZ系）を主成分とする材料、ニッケルニオブ酸鉛を主成分とする材料、亜鉛ニオブ酸鉛を主成分とする材料、マンガンニオブ酸鉛を主成分とする材料、マグネシウムタンタル酸鉛を主成分とする材料、ニッケルタンタル酸鉛を主成分とする材料、アンチモンスズ酸鉛を主成分とする材料、チタン酸鉛を主成分とする材料、マグネシウムタンゲステン酸鉛を主成分とする材料、コバルトイオブ酸鉛を主成分とする材料又はこれらの任意の組合せを含有する複合材料を用いることができ、これらのうち、ジルコン酸鉛を含有するセラミックスが圧電材料及び／又は電歪材料として最も使用頻度が高い。

圧電材料及び／又は電歪材料をセラミックスとした場合、上記材料に、ランタン、バリウム、ニオブ、亜鉛、セリウム、カドミウム、クロム、コバルト、アンチモン、鉄、イットリウム、タンタル、タンゲステン、ニッケル、マンガン、リチウム、ストロンチウム、ビスマス等の酸化物若しくはこれらのいずれかの組合せ又は他の化合物を適切に添加した適切な材料とし、例えばPLZT系となるようにその材料に所定の添加物を加えたものも好適に用いられる。

これら圧電材料及び／又は電歪材料の中でも、マグネシウムニオブ酸鉛とジルコン酸鉛とチタン酸鉛とからなる成分を主成分とする材料、ニッケルニオブ酸鉛とマグネシウムニオブ酸鉛とジルコン酸鉛とチタン酸鉛とからなる成分を主成分とする材料、マグネシウムニオブ酸鉛とニッケルタンタル酸鉛とジルコン酸鉛とチタン酸鉛とからなる成分を主成分とする材料、マグネシウムタンタル酸鉛とマグネシウムニオブ酸鉛とジルコン酸鉛とチタン酸鉛とからなる成分を主成分とする材料、これらの材料の鉛の一部をストロンチウム及び／又はランタンで置換したもの等が好適に用いられ、上記スクリーン印刷などの厚膜形成手法で電界印加部 51a, 51bを形成する場合の材料として好適である。

多成分系圧電材料及び／又は電歪材料の場合、成分の組成によって、圧電及び／又は電歪特性が変化するが、第6の実施の形態で好適に採用されるマグネシウムニオブ酸鉛—ジルコン酸鉛—チタン酸鉛の3成分系材料や、マグネシウムニオブ酸鉛—ニッケルタンタル酸鉛—チタン酸鉛及びマグネシウムタンタル酸鉛—マグネシウムニオブ酸鉛—ジルコン酸鉛—チタン酸鉛の4成分系材料では、綈立方晶—正方晶—菱面体晶の相境界付近の組成が好ましく、特に、マグネシウムニオブ酸鉛：15—50モル%、ジルコン酸鉛：10—45モル%、チタン酸鉛：30—45モル%の組成や、マグネシウムニオブ酸鉛：15—50モル%、ニッケルタンタル酸鉛：10—40モル%、ジルコン酸鉛：10—45モル%、チタン酸鉛：30—45モル%の組成及びマグネシウムニオブ酸鉛：15—50モル%、マグネシウムタンタル酸鉛：10—40モル%、ジルコン酸鉛：10—45モル%、チタン酸鉛：30—45モル%の組成が、高圧電定数及び項電気機械結合係数を有する理由から好適に採用される。

## 請求の範囲

1. 誘電体によって構成された電界印加部と、  
この電界印加部の一方の面に形成された第1電極と、  
前記電界印加部の一方の面に形成され、前記第1電極とともにスリットを形成  
する第2電極とを有することを特徴とする電子放出素子。
2. 請求の範囲1記載の電子放出素子において、  
前記第1電極、第2電極及びスリットにカーボンコーティングを施したこと  
を特徴とする電子放出素子。
3. 請求の範囲1又は2記載の電子放出素子において、  
前記第1及び第2電極に対して所定の間隔を以って配置した第3電極を更に  
有し、  
前記第1及び第2電極と前記第3電極との間の空間を真空としたことを特徴と  
する電子放出素子。
4. 圧電材料、電歪材料及び反強誘電材料のうちの少なくとも1種類によって構  
成された電界印加部と、  
この電界印加部の一方の面に形成された第1電極と、  
前記電界印加部の一方の面に形成され、前記第1電極とともにスリットを形成  
する第2電極とを有することを特徴とする電子放出素子。
5. 請求の範囲4記載の電子放出素子において、  
前記第1電極、第2電極及びスリットにカーボンコーティングを施したこと  
を特徴とする電子放出素子。
6. 請求の範囲4又は5記載の電子放出素子において、  
前記第1及び第2電極に対して所定の間隔を以って配置した第3電極を更に有  
し、  
前記第1及び第2電極と前記第3電極との間の空間を真空としたことを特徴

とする電子放出素子。

7. 請求の範囲 6 記載の電子放出素子において、

前記電界印加部がアクチュエータとしても機能し、その変位動作によって、  
放出電子量を制御することを特徴とする電子放出素子。

8. 請求の範囲 3, 6, 7 の何れか一つの請求の範囲に記載の電子放出素子にお  
いて、

前記第 3 電極に直流のオフセット電圧を印加する電圧源と、  
この電圧源と前記第 3 電極との間に直列配置した抵抗とを更に有することを  
特徴とする電子放出素子。

9. 請求の範囲 1 – 8 の何れか一つの請求の範囲に記載の電子放出素子において、  
前記第 1 電極にパルス電圧が印加されるとともに、前記第 2 電極に直流のオ  
フセット電圧が印加されることを特徴とする電子放出素子。

10. 請求の範囲 1 – 9 の何れか一つの請求の範囲に記載の電子放出素子にお  
いて、

前記第 1 電極と電圧信号源との間に直列配置したコンデンサを更に有するこ  
とを特徴とする電子放出素子。

11. 請求の範囲 1 – 8 の何れか一つの請求の範囲に記載の電子放出素子にお  
いて、

前記電界印加部の他方の面に形成され、前記第 1 電極に対応する第 4 電極を  
更に有することを特徴とする電子放出素子。

12. 請求の範囲 11 記載の電子放出素子において、

前記第 4 電極にパルス電圧が印加されるとともに、前記第 2 電極に直流のオ  
フセット電圧が印加されることを特徴とする電子放出素子。

13. 請求の範囲 1 – 12 の何れか一つの請求の範囲に記載の電子放出素子にお  
いて、

前記第 2 電極と直流オフセット電圧源との間に直列配置した抵抗を更に有す

ることを特徴とする電子放出素子。

14. 請求の範囲1-13の何れか一つの請求の範囲に記載の電子放出素子において、

前記電界印加部の比誘電率を1000以上としたことを特徴とする電子放出素子。

15. 請求の範囲1-14の何れか一つの請求の範囲に記載の電子放出素子において、

前記スリットの幅を500μm以下としたことを特徴とする電子放出素子。

16. 請求の範囲1-15の何れか一つの請求の範囲に記載の電子放出素子において、

前記第1電極と第2電極のうちの少なくとも一方が、鋭角を成す角部を有することを特徴とする電子放出素子。

17. 請求の範囲1-16の何れか一つの請求の範囲に記載の電子放出素子において、

前記第1電極及び第2電極がカーボンナノチューブを有することを特徴とする電子放出素子。

18. 2次元的に配列された複数の電子放出素子と、

これら電子放出素子に対してそれぞれ所定の間隔を以って配置した複数の萤光体とを具え、

前記電流放出素子の各々が、

誘電体によって構成された電界印加部と、

この電界印加部の一方の面に形成された第1電極と、

前記電界印加部の一方の面に形成され、前記第1電極とともにスリットを形成する第2電極とを有することを特徴とするフィールドエミッショันディスプレイ。

19. 請求の範囲18記載のフィールドエミッショันディスプレイにおいて、

前記第1電極、第2電極及びスリットにカーボンコーティングを施したこと  
を特徴とする電子放出素子。

20. 請求の範囲18又は19記載のフィールドエミッションディスプレイにお  
いて、

前記蛍光体の各々の前記第1及び第2電極に対向する面とは反対側の面に、  
第3電極をそれぞれ配置し、

前記第1及び第2電極と前記蛍光体との間の空間を真空としたことを特徴と  
するフィールドエミッションディスプレイ。

21. 2次元的に配列された複数の電子放出素子と、

これら電子放出素子に対してそれぞれ所定の間隔を以って配置した複数の螢  
光体とを具え、

前記電流放出素子の各々が、

圧電材料、電歪材料及び反強誘電材料のうちの少なくとも1種類によって構  
成された電界印加部と、

この電界印加部の一方の面に形成された第1電極と、  
前記電界印加部の一方の面に形成され、前記第1電極とともにスリットを形成  
する第2電極とを有することを特徴とするフィールドエミッションディスプ  
レイ。

22. 請求の範囲21記載の電子放出素子において、

前記第1電極、第2電極及びスリットにカーボンコーティングを施したこと  
を特徴とする電子放出素子。

23. 請求の範囲21又は22記載のフィールドエミッションディスプレイにお  
いて、

前記蛍光体の各々の前記第1及び第2電極に対向する面とは反対側の面に、  
第3電極をそれぞれ配置し、

前記第1及び第2電極と前記蛍光体との間の空間を真空としたことを特徴と

するフィールドエミッションディスプレイ。

24. 請求の範囲23記載のフィールドエミッションディスプレイにおいて、前記電界印加部がアクチュエータとしても機能し、その変位動作によって、放出電子量を制御することを特徴とするフィールドエミッションディスプレイ。

25. 請求の範囲20, 23, 24の何れか一つの請求の範囲に記載のフィールドエミッションディスプレイにおいて、

前記電子放出素子の各々が、

前記第3電極に直流のオフセット電圧を印加する電圧源と、

この電圧源と前記第3電極との間に直列配置した抵抗とを更に有することを特徴とする電子放出素子。

26. 請求の範囲18-25の何れか一つの請求の範囲に記載のフィールドエミッショニスプレイにおいて、

前記第1電極にパルス電圧が印加されるとともに、前記第2電極に直流のオフセット電圧が印加されることを特徴とするフィールドエミッションディスプレイ。

27. 請求の範囲18-26の何れか一つの請求の範囲に記載のフィールドエミッショニスプレイにおいて、

前記電流放出素子の各々が、

前記第1電極と電圧信号源との間に直列配置したコンデンサを更に有することを特徴とするフィールドエミッションディスプレイ。

28. 請求の範囲18-26の何れか一つの請求の範囲に記載のフィールドエミッショニスプレイにおいて、

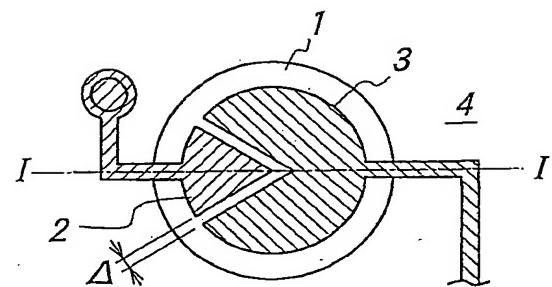
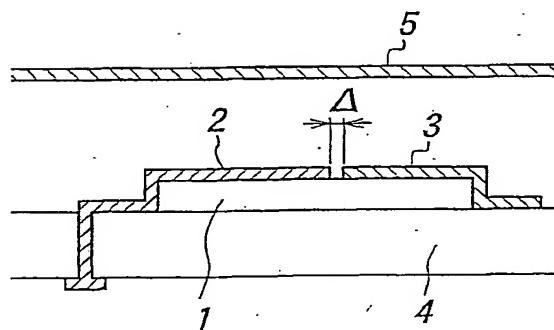
前記電流放出素子の各々が、

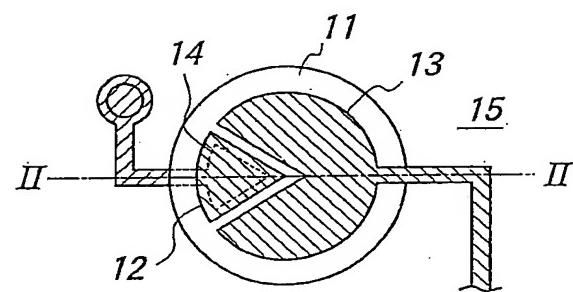
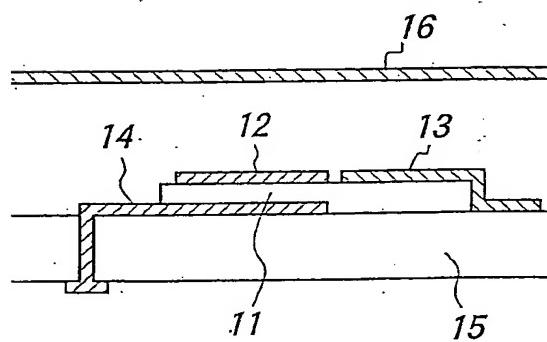
前記電界印加部の他方の面に形成され、前記第1電極に対応する第4電極を更に有することを特徴とするフィールドエミッションディスプレイ。

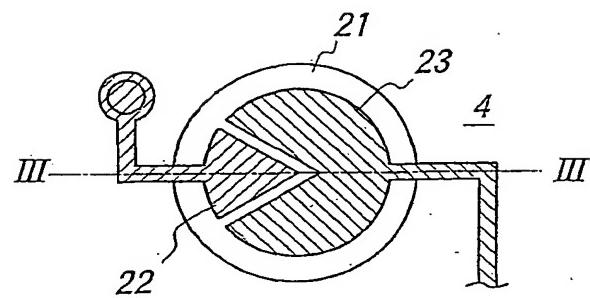
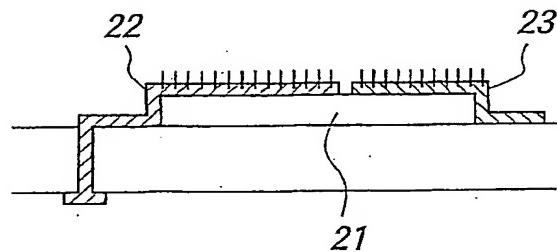
29. 請求の範囲 28 記載のフィールドエミッショニスプレイにおいて、前記第4電極にパルス電圧が印加されるとともに、前記第2電極に直流のオフセット電圧が印加されることを特徴とするフィールドエミッショニスプレイ。
30. 請求の範囲 18-29 の何れか一つの請求の範囲に記載のフィールドエミッショニスプレイにおいて、前記電流放出素子の各々が、前記第2電極と直流オフセット電圧源との間に直列配置した抵抗を更に有することを特徴とするフィールドエミッショニスプレイ。
31. 請求の範囲 18-30 の何れか一つの請求の範囲に記載のフィールドエミッショニスプレイにおいて、前記電界印加部の比誘電率を 1000 以上としたことを特徴とするフィールドエミッショニスプレイ。
32. 請求の範囲 18-31 の何れか一つの請求の範囲に記載のフィールドエミッショニスプレイにおいて、前記スリットの幅を  $5.00 \mu\text{m}$  以下としたことを特徴とするフィールドエミッショニスプレイ。
33. 請求の範囲 18-32 の何れか一つの請求の範囲に記載のフィールドエミッショニスプレイにおいて、前記第1電極と第2電極のうちの少なくとも一方が、鋭角を成す角部を有することを特徴とするフィールドエミッショニスプレイ。
34. 請求の範囲 18-33 の何れか一つの請求の範囲に記載のフィールドエミッショニスプレイにおいて、前記第1電極及び第2電極がカーボンナノチューブを有することを特徴とするフィールドエミッショニスプレイ。
35. 請求の範囲 18-34 の何れか一つの請求の範囲に記載のフィールドエミ

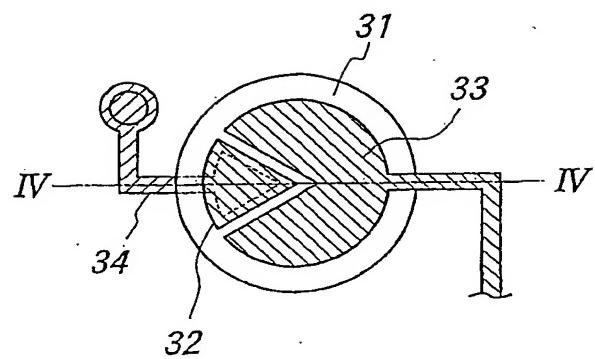
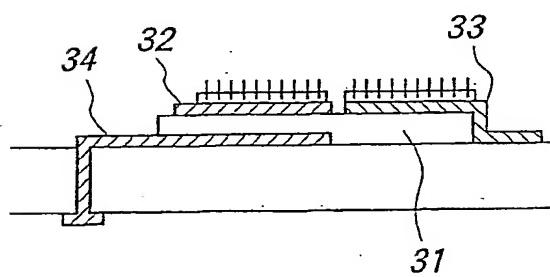
ッショングディスプレイにおいて、

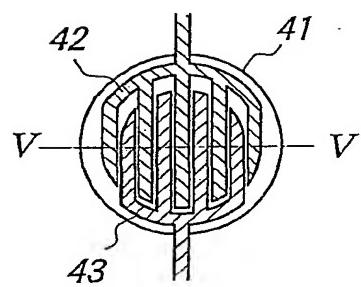
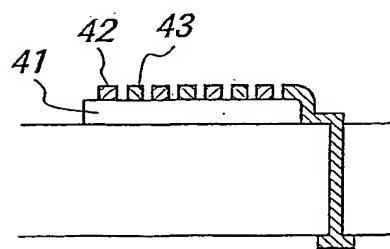
2次元的に配列された複数の電子放出素子を一体に形成した基板を更に具えることを特徴とするフィールドエミッショングディスプレイ。

*FIG. 1A**FIG. 1B*

*FIG. 2A**FIG. 2B*

*FIG. 3A**FIG. 3B*

*FIG. 4A**FIG. 4B*

*FIG. 5A**FIG. 5B*

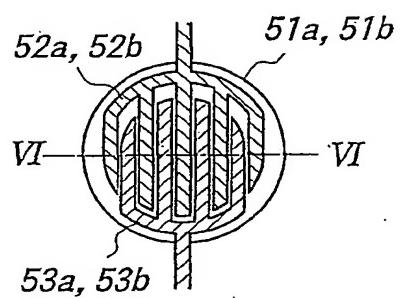
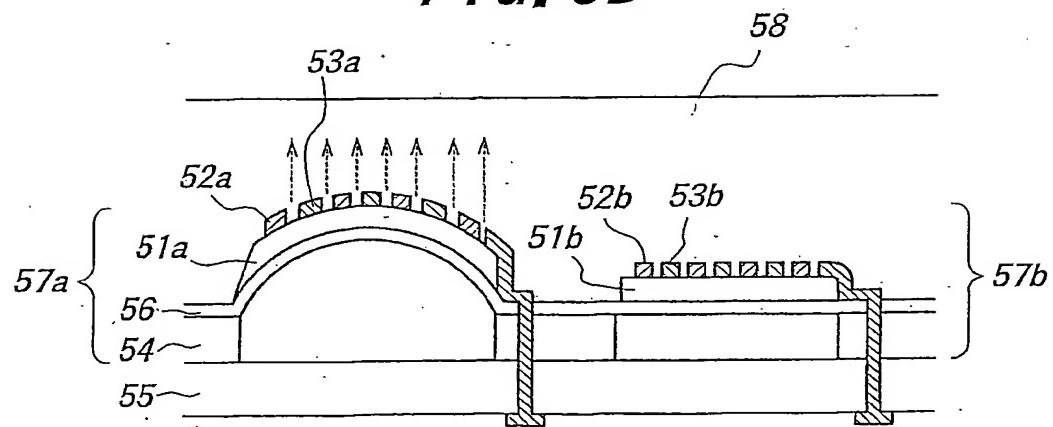
*FIG. 6A**FIG. 6B*

FIG. 7A

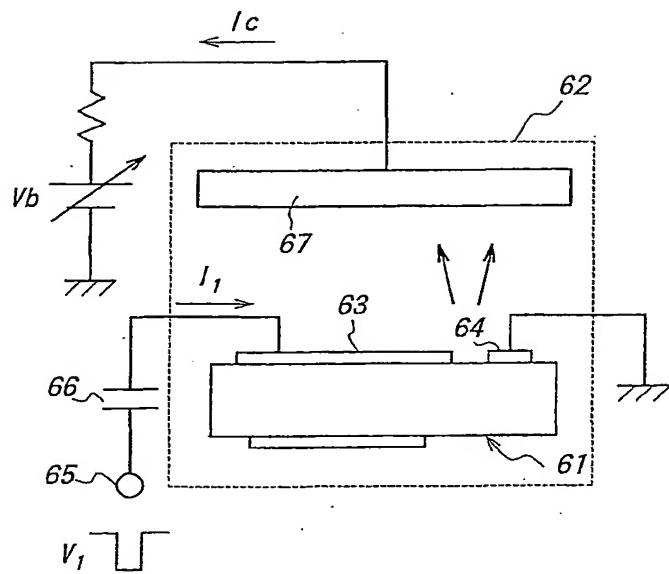
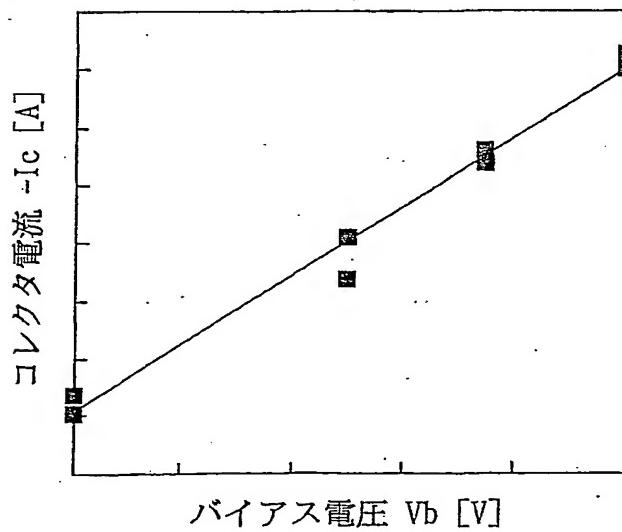


FIG. 7B



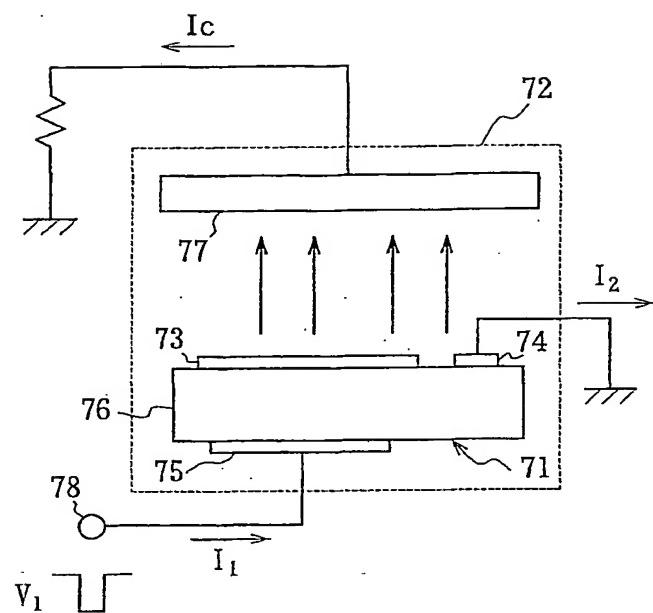
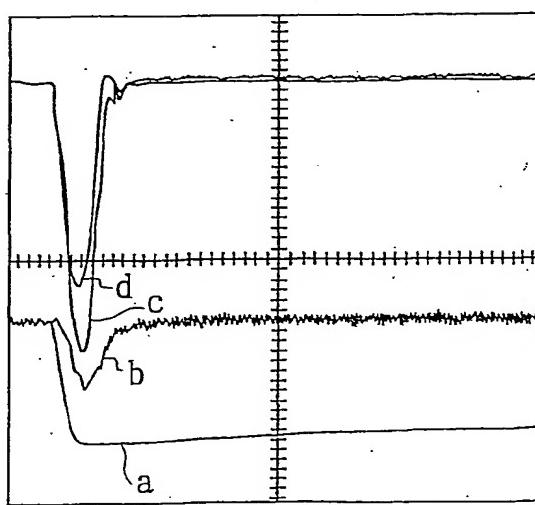
*FIG. 8A**FIG. 8B*

FIG. 9

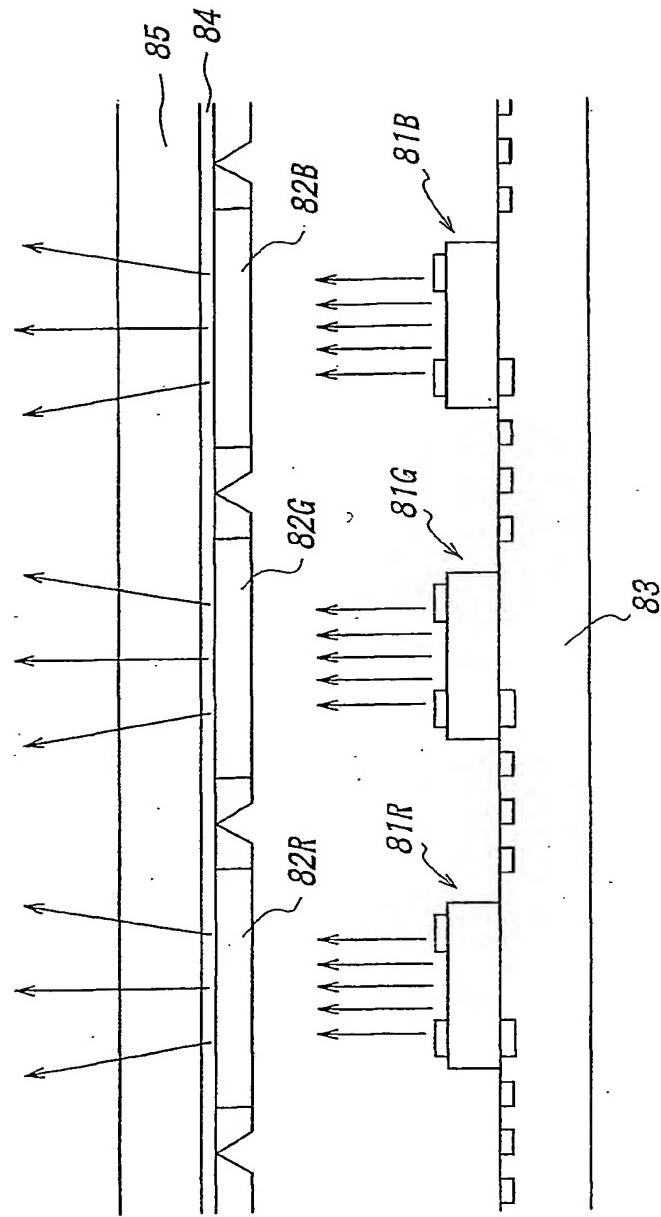
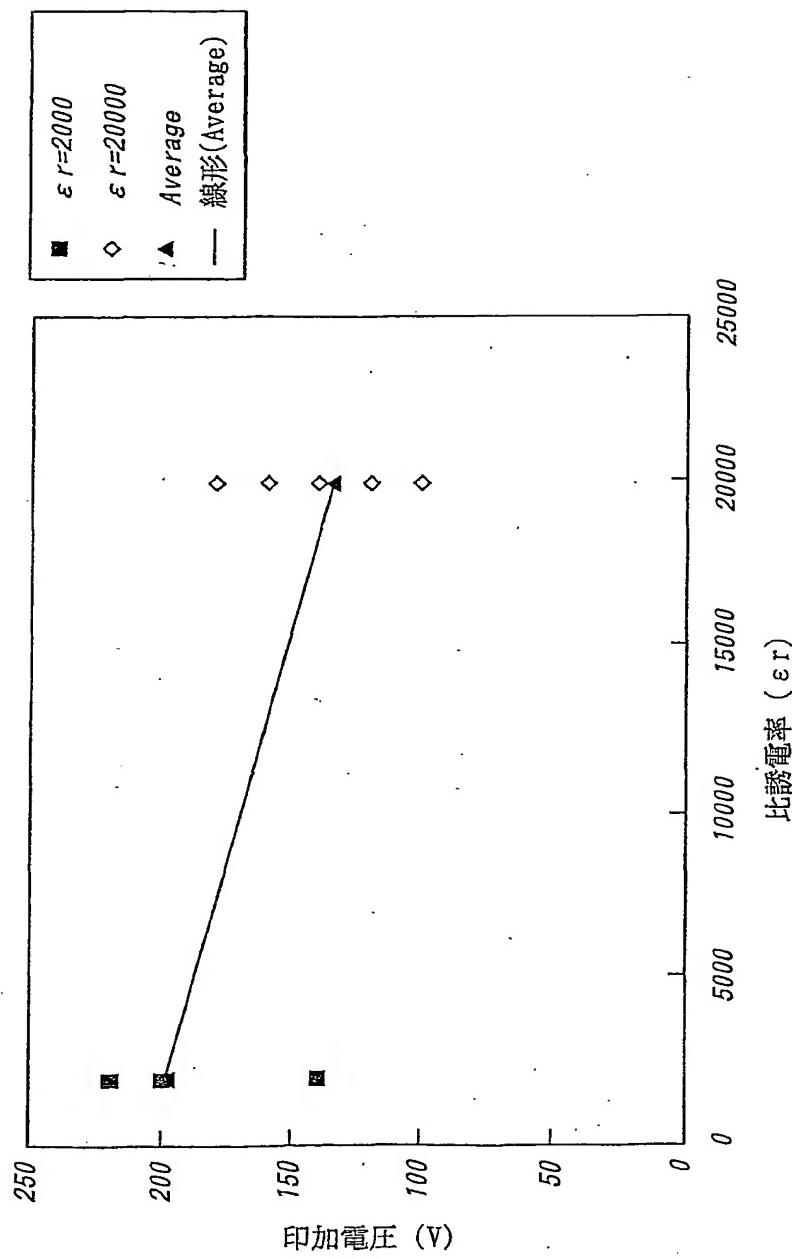


FIG. 10



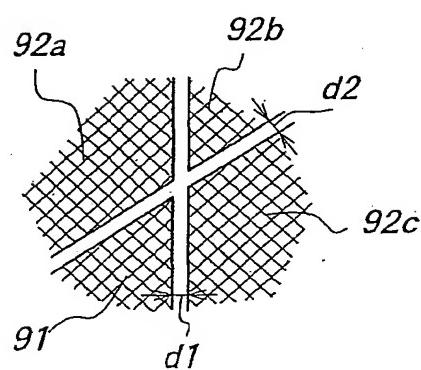
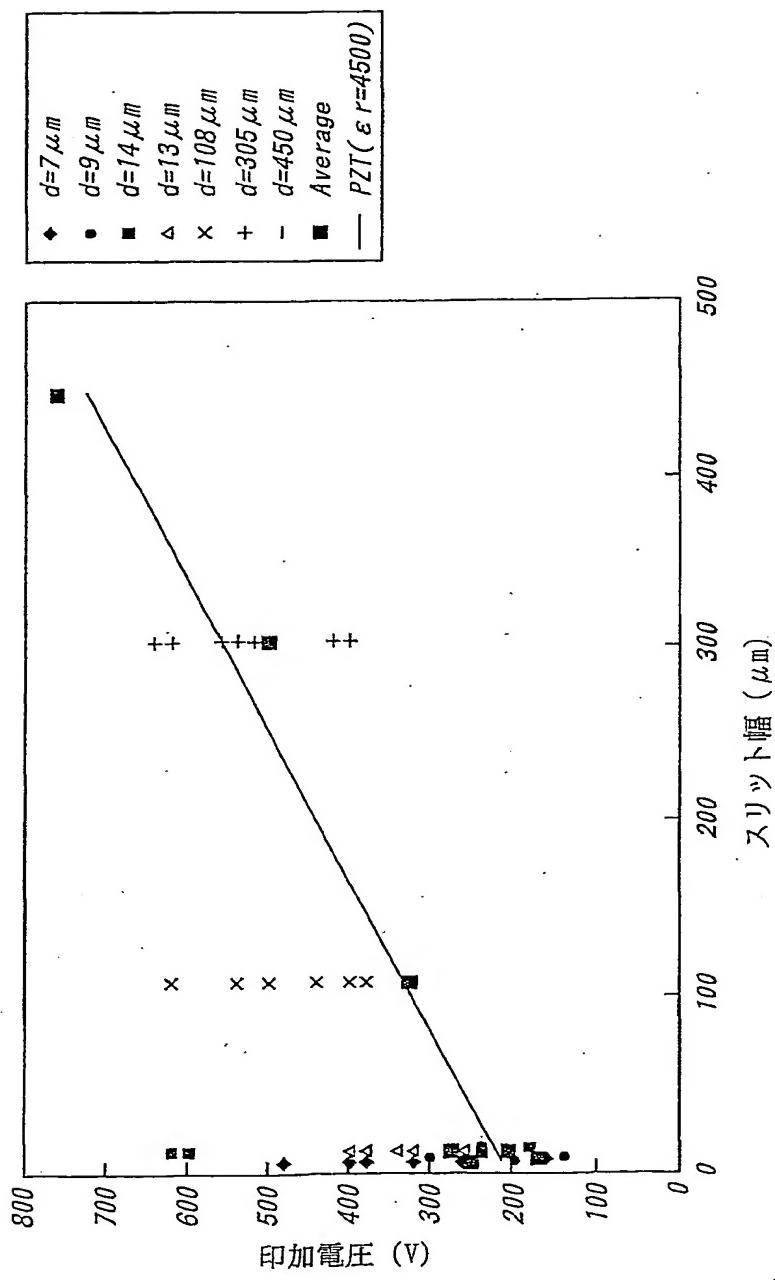
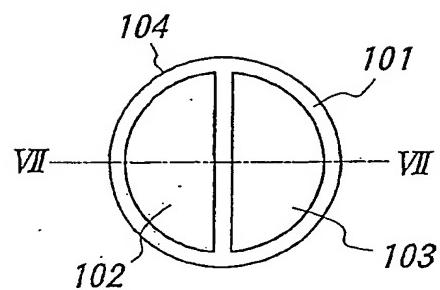
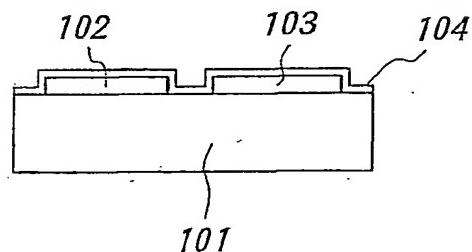
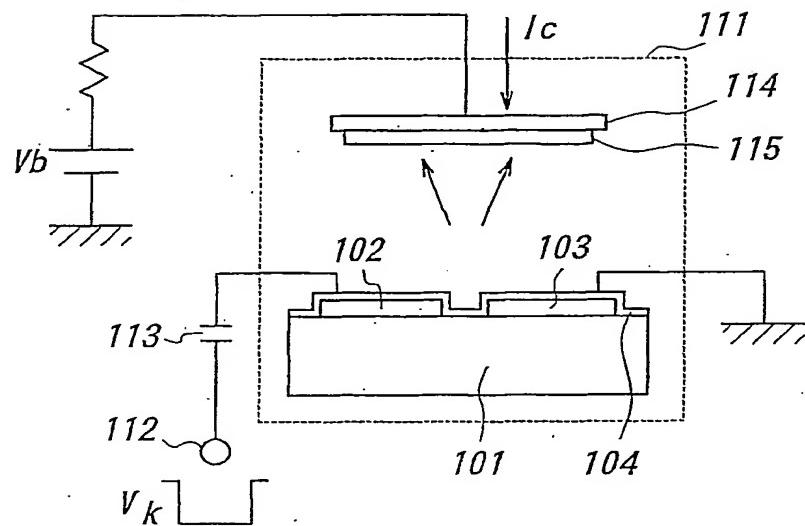
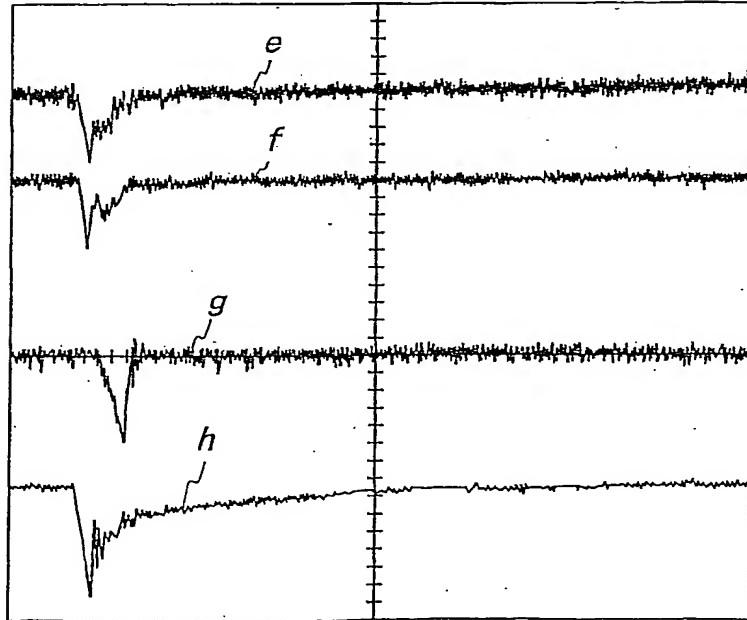
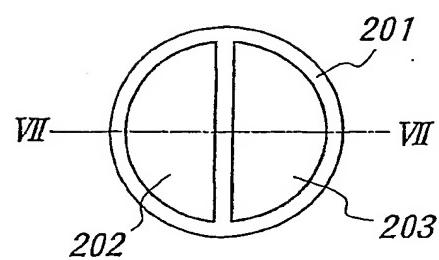
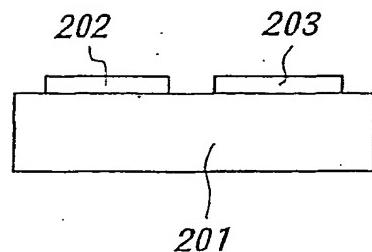
*FIG. 11*

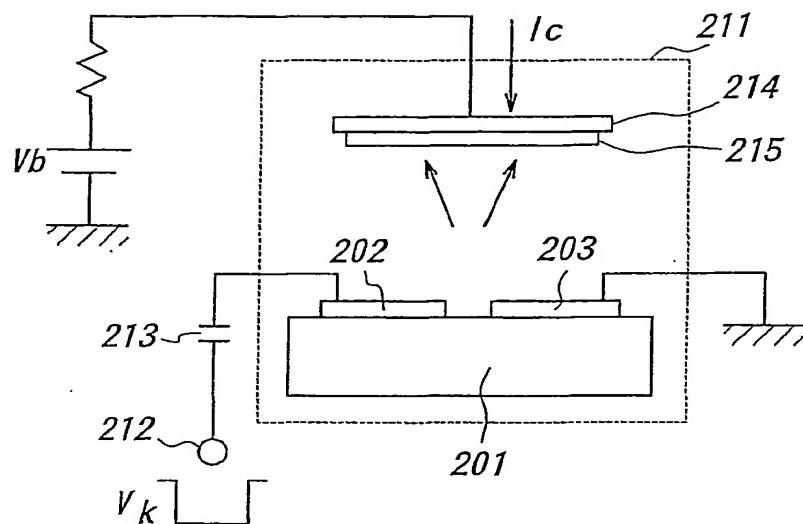
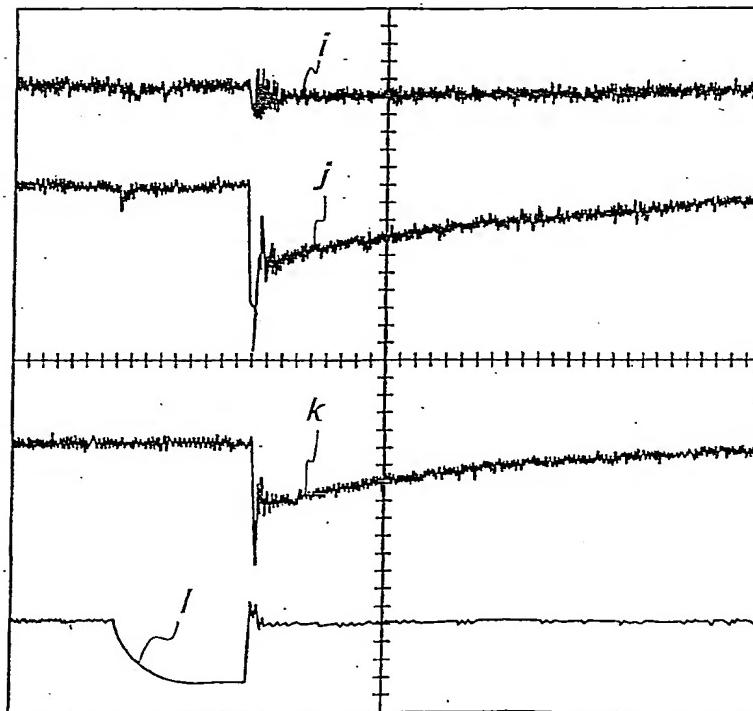
FIG. 12



*FIG. 13A**FIG. 13B*

**FIG. 14A****FIG. 14B**

*FIG. 15A**FIG. 15B*

**FIG. 16A****FIG. 16B**

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/11195

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl<sup>7</sup> H01J1/304, H01J1/316, H01J29/04, H01J31/12

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl<sup>7</sup> H01J1/304, H01J1/316, H01J29/04, H01J31/12

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched  
 Jitsuyo Shinan Koho 1940-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2002  
 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2002 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2002

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP, 7-147131, A (TDK K.K.), 06 June, 1995 (06.06.95), Full text; Figs. 8, 9 (Family: none)	1,15,16 3,18,32,33
Y	JP, 2000-285801, A (Canon Inc.), 13 October, 2000 (13.10.00), Full text; all drawings (Family: none)	3,18,32,33
X	JP, 1-311533, A (Canon Inc.), 15 December, 1989 (15.12.89), Full text; all drawings (Family: none)	1,15
X	JP, 46-20944, B (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 12 June, 1971 (12.06.71), Full text; all drawings (Family: none)	1,16

 Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T"	later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X"	earlier document but published on or after the international filing date
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"Y"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means		document member of the same patent family
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		

Date of the actual completion of the international search 02 April, 2002 (02.04.02)	Date of mailing of the international search report 16 April, 2002 (16.04.02)
--	---

Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/11195

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP, 44-26125, B (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 04 November, 1969 (04.11.69), Full text; all drawings (Family: none)	1-35

## 国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP01/11195

## A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' H01J1/304, H01J1/316, H01J29/04, H01J31/12

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' H01J1/304, H01J1/316, H01J29/04, H01J31/12

## 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1940-1996年  
 日本国公開実用新案公報 1971-2002年  
 日本国登録実用新案公報 1994-2002年  
 日本国実用新案登録公報 1996-2002年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 7-147131 A (ティーディーケイ株式会社)	1, 15, 16
Y	1995. 06. 06 全文, 図8, 図9 (ファミリーなし)	3, 18, 32, 33
Y	JP 2000-285801 A (キャノン株式会社) 2000. 10. 13 全文, 全図 (ファミリーなし)	3, 18, 32, 33
X	JP 1-311533 A (キャノン株式会社) 1989. 12. 15 全文, 全図 (ファミリーなし)	1, 15

 C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

## の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

02. 04. 02

国際調査報告の発送日

16.04.02

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)  
 郵便番号100-8915  
 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許序審査官(権限のある職員)

村田 尚英

2G 8117



電話番号 03-3581-1101 内線 6488

C (続き) 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	J P 4 6 - 2 0 9 4 4 B (松下電器産業株式会社) 1 9 7 1 . 0 6 . 1 2 全文, 全図 (ファミリーなし)	1, 16
A	J P 4 4 - 2 6 1 2 5 B (松下電器産業株式会社) 1 9 6 9 . 1 1 . 0 4 全文, 全図 (ファミリーなし)	1 - 3 5